Klausur

Name: Matrikel-Nr.:

Vorname: abgegeben: Aufgabenblatt + Blätter

1 Phasenübergang Eisen

Für Eisen beobachtet man unter sehr hohem Druck (Größenordnung 130 kbar) einen strukturellen Phasenübergang von der kubisch-raumzentrierten (bcc) zur hexagonal-dichtesten (hcp) Packung.

- a) Schätzen Sie die relative Volumenänderung ab unter der Annahme, dass die Atome als harte Kugeln beschrieben werden können, deren Radius und Dichte sich am Phasenübergang nicht ändern.
- b) Warum ist (auch ohne Kenntnis der Hochdruck-Struktur) das Auftreten des kubisch-primitiven (sc) Gitters bei sehr hohem Druck unwahrscheinlich?

Bitte in beiden Aufgabenteilen a) und b) Rechnungen nachvollziehbar ausführen.

2 Strukturfaktor von Caesiumchlorid (CsCl)

- a) Berechnen Sie den Strukturfaktor S_{hkl} für die Caesiumchloridstruktur (CsCl). Cs⁺ und Cl⁻ haben unterschiedliche Atomformfaktoren f_1 bzw. f_2 .
- b) Wie kann man ausgehend vom Ergebnis für die CsCl-Struktur den Strukturfaktor für die einatomige bcc-Struktur ableiten (bezogen auf die kubische Einheitszelle)? Wie sieht dieser aus?
- c) Für welche Tripel h, k, l treten in der bcc-Struktur Beugungsreflexe auf bzw. welche Tripel h, k, l führen zur Auslöschung von Beugungsreflexen?

Hinweis: CsCl ist einfach kubisch, die Einheitszelle hat 2 Basisatome bei $(u_{\alpha}, v_{\alpha}, w_{\alpha}) = (0, 0, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

3 Punktdefekte

Die Konzentration der Punktdefekte in einem Kristall können wir aus statistischen Überlegungen herleiten. Zur Erzeugung eines Defekts müssen wir die Energie E aufwenden; die Entropie S wird dabei wegen der Verringerung der Gitterordnung größer. Wenn N Defekte bei insgesamt $N_{\rm ges}$ Gitterplätzen auftreten, beträgt der Entropiezuwachs gegenüber dem perfekten Kristall:

$$\Delta S = k_B \ln \frac{N_{\text{ges}}!}{(N_{\text{ges}} - N)!N!} \tag{1}$$

und die Änderung der freien Energie für N Punktdefekte ist

$$\Delta F = \Delta U - T \cdot \Delta S = N \cdot E - k_B T \ln \frac{N_{\text{ges}}!}{(N_{\text{ges}} - N)! N!}$$
 (2)

- a) Formen Sie Gleichung (2) mit Hilfe der Stirling-Formel ($\ln X! \approx X \cdot \ln X X$ [für große X]) so um, dass keine Fakultäten mehr auftauchen! Sowohl $N_{\rm ges}$ als auch N seien absolut gesehen als große Zahlen zu betrachten, so dass die Stirling-Formel in sehr guter Näherung erfüllt ist.
- b) Der Gleichgewichtszustand ist durch $\left(\frac{\partial \Delta F}{\partial N}\right)_{T=const.}$ $\stackrel{!}{=}$ 0 charakterisiert. Zeigen Sie, dass daraus folgt:

$$\ln \frac{N}{N_{\text{ges}} - N} = -\frac{E}{k_B T} \quad .$$
(3)

c) Für $N \ll N_{\rm ges}$ folgt aus Gleichung (3) durch Vernachlässigen von N im Nenner:

$$n = \frac{N}{N_{\rm ges}} \approx \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \tag{4}$$

Hierbei ist n die Punktdefektkonzentration im Kristall, also wieviele Punktdefekte pro Gitterplatz bei einer bestimmten Temperatur existieren. Wie groß ist n bei $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ und bei einer angenommenen Bildungsenergie für einen Defekt von $E=1\,\mathrm{eV}$? Benutzen Sie $k_B=8,617\cdot10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$.

4 Verschiebung der Fermi-Kugel

Längs eines kristallinen Kupferstabes werde zur Zeit t=0 ein zeitlich konstantes elektrisches Feld der Stärke $E=1000\,\mathrm{V/m}$ angelegt. Infolge der Stöße zwischen Elektronen mit Verunreinigungen, Gitterfehlern oder Phononen kann die Verschiebung Δk der Fermi-Kugel nach endlicher Zeit $t=\tau$ als stationärer Zustand aufrecht erhalten werden, wobei τ ein Maß für die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen sei.

- a) Wie groß ist die Verschiebung Δk der Fermi-Kugel? Leiten Sie einen Ausdruck als Funktion der elektrischen Feldstärke E und der elektrischen Leitfähigkeit σ her! Berechnen Sie Δk , inklusive Einheitenbetrachtung! Benutzen Sie dazu die Werte: $\sigma_{\rm Cu} = 5, 8 \cdot 10^7 \, {\rm A/(V\,m)}, \ n_{\rm Cu} = 8, 5 \cdot 10^{28} \, {\rm m}^{-3}, \ m_e = 9, 11 \cdot 10^{-31} \, {\rm kg}, \ \hbar = 1,05 \cdot 10^{-34} \, {\rm kg \, m^2 \, s^{-1}}, \ e = 1,602 \cdot 10^{-19} \, {\rm A \, s}.$
- b) Bestimmen Sie für ein kubisch flächenzentriertes (fcc) Gitter die maximale Ausdehnung k_{max} eines Wellenvektors entlang der Raumdiagonale der 1. Brillouin-Zone (BZ), siehe Abbildung 1!
- c) Kupfer besitzt ein fcc-Gitter mit der Gitterkonstante $a \approx 0,36\,\mathrm{nm}$. Vergleichen Sie Δk mit k_{max} aus Aufgabenteil b) größenordnungsmäßig für Kupfer! Ist es wahrscheinlich, dass die Elektronen bei solchen E-Feldern den Rand der 1. BZ erreichen und Bloch-Oszillationen ausführen können?

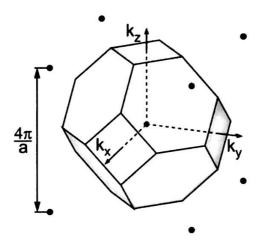


Abbildung 1: Reziprokes Gitter und 1. Brillouin-Zone des fcc-Gitters.

5 Tight-Binding-Modell bcc

Die Bandstruktur des vereinfachten tight-binding-Modells hat die Form

$$E(\vec{k}) = E_0 - t \sum_{j} \exp\left(i\vec{k} \cdot \vec{r_j}\right) \tag{5}$$

wobei die Summe über alle solchen Vektoren \vec{r}_j des Bravais-Gitters läuft, die das Atom im Ursprung mit den jeweiligen nächsten Nachbarn verbinden. Die Größe t ist das für alle nächsten Nachbarn als gleich angenommene Überlappungsintegral.

Berechnen Sie $E(\vec{k})$ für ein bec-Gitter, ausgedrückt durch E_0 , t und $\cos\left(\frac{k_i a}{2}\right)$, mit i=x,y,z.

Viel Erfolg!!!

Bitte beachten: Zwischenschritte werden bepunktet, daher Lösungswege klar und ausführlich darstellen!